Express Mail Label No.	Dated:

Docket No.: 09856/0200497-US0

(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of: Hiroshi Suzuki

Application No.: Not Yet Assigned

Confirmation No.:

Filed: Concurrently Herewith

Art Unit: N/A

For: BOOSTER CIRCUIT AND METHOD FOR

CONTROLLING THE SAME

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

Country Application No. Date 2003-112981 April 17, 2003 Japan

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: February 27, 2004

Joseph R. Robinson

Registration No.: 33,448 DARBY & DARBY P.C.

P.O. Box 5257

New York, New York 10150-5257

(212) 527-7700

(212) 753-6237 (Fax)

Attorneys/Agents For Applicant



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 4月17日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-112981

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[JP2003-112981]

出 願 人

豊田工機株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月28日





【書類名】

【整理番号】 PY20030375

【提出日】 平成15年 4月17日

特許願

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H02M 3/155

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市朝日町1丁目1番地 豊田工機株式会社内

【氏名】 鈴木 浩

【特許出願人】

【識別番号】 000003470

【氏名又は名称】 豊田工機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100068755

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 博宣

【選任した代理人】

【識別番号】 100105957

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002956

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9720003

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 昇圧回路及び昇圧回路の制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 スイッチング素子がオンのときにコイルにエネルギーを蓄え、オフのときにこのエネルギーを入力電圧に重畳して出力側に設けられたコンデンサを充電する昇圧回路において、

前記入力電圧と、前記コンデンサ側の実昇圧電圧を検出する検出手段と、

目標昇圧電圧を設定する目標昇圧電圧設定手段と、

前記目標昇圧電圧と、前記実昇圧電圧の偏差を解消するようにデューティ比を 設定するデューティ比設定手段と、

前記入力電圧に基づいて得られる入力電圧変動量に応じた補正量を算出し、前記デューティ比を同補正量にて補正して、新たなデューティ比に基づき、前記スイッチング素子をオンオフ作動してフィードバック制御を行う制御手段を備えたことを特徴とする昇圧回路。

【請求項2】 前記補正量は、

前記入力電圧に基づき算出した入力電圧変動量と前記目標昇圧電圧との比であることを特徴とする請求項1に記載の昇圧回路。

【請求項3】 前記補正量は、

前記入力電圧に基づき算出した入力電圧変動量と前記実昇圧電圧との比であることを特徴とする請求項1に記載の昇圧回路。

【請求項4】 スイッチング素子がオンのときにコイルにエネルギーを蓄え、オフのときにこのエネルギーを入力電圧に重畳して出力側に設けられたコンデンサを充電する昇圧回路の制御方法において、

前記入力電圧と、前記コンデンサ側の実昇圧電圧を検出し、

目標昇圧電圧と、前記実昇圧電圧の偏差を解消するようにデューティ比を設定 し、

前記入力電圧に基づいて得られる入力電圧変動量に応じた補正量を算出し、

前記デューティ比を同補正量にて補正した新たなデューティ比に基づいて、前 記スイッチング素子をオンオフ作動してフィードバック制御を行うことを特徴と する昇圧回路の制御方法。

【請求項5】 前記補正量は、

前記入力電圧に基づき算出した入力電圧変動量と前記目標昇圧電圧との比であることを特徴とする請求項4に記載の昇圧回路の制御方法。

【請求項6】 前記補正量は、前記入力電圧に基づき算出した入力電圧変動量と前記実昇圧電圧との比であることを特徴とする請求項4に記載の昇圧回路の制御方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、昇圧回路及び昇圧回路の制御方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来から、図5に示すような、昇圧回路が知られている(特許文献1参照)。 昇圧回路300はバッテリBと電気負荷Fとの間に設けられたコイルLとダイオードDの直列回路を備え、コイルLとダイオードDとの間にコイルLに励磁電流を流したり、遮断したりするためのトランジスタQ1(例えば、MOS-FET))を備えている。又、ダイオードDのカソード側はコンデンサCを介して接地されている。又、昇圧回路300は、トランジスタQ1をオンオフ制御する昇圧制御部400を備えている。

[0003]

昇圧制御部400は、図示しないROM、RAM、CPU(中央演算処理装置)等を備えたECU(電子制御装置)から構成されている。なお、図5において、昇圧制御部400内のブロックは、前記ROM内に格納された昇圧制御プログラムにより、前記CPUが実行する機能を示す制御ブロックを示しており、図示されている各部は、独立したハードウエアを示すものではなく、前記制御プログラムで実行される機能を示す。

[0004]

昇圧制御部400は、目標昇圧電圧設定部410、フィードバック制御部42

0、PWM出力部430を備える。目標昇圧電圧設定部410は、前記ROMに 予め格納された目標昇圧電圧Vbpig*を読み込みして、目標昇圧電圧Vbpig*を フィードバック制御部420に出力する。

[0005]

フィードバック制御部420は、目標昇圧電圧Vbpig*と図示しないA/D変換部を介して入力した実昇圧電圧Vbpigとの偏差を算出し、その偏差を縮小すべく、すなわち、フィードバック制御を行うために、比例(P)・積分(I)・微分(D)処理を施して、トランジスタQ1の制御量を演算する。さらに、フィードバック制御部420は、演算した制御量に対応するデューティ比(オンデューティ)αを演算して、PWM出力部430に出力する。

[0006]

PWM出力部430では、前記デューティ比(オンデューティ) α に基づいてデューティ比駆動信号(PWM駆動信号)に変換し、該変換したデューティ比駆動信号を昇圧回路300のトランジスタQ1に印加する。このデューティ比駆動信号により、トランジスタQ1は、デューティ制御される。

[0007]

すなわち、このデューティ制御により、トランジスタQ1が図6に示すようにスイッチング動作を行ない、この結果、コイルLでエネルギーの蓄積と放出とが繰り返され、ダイオードDのカソード側に放出の際の高電圧が現れる。なお、図6に示すように本明細書中、Ταはオン時間、Τはパルス周期、αはデューティ比(オンデューティ)を示している。

[0008]

トランジスタQ1がオンとなるとコイルLに電流が流れ、トランジスタQ1がオフとなるとコイルLに流れる電流が遮断される。コイルLに流れる電流が遮断されると、この電流の遮断による磁束の変化を妨げるように、ダイオードDのカソード側に高電圧が発生する。この繰り返しによって、ダイオードDのカソード側に高電圧が繰り返し発生し、コンデンサCで平滑(充電)され、昇圧されたコンデンサ電圧(以下、実昇圧電圧Vbpigという)が得られる。

[0009]

このとき、昇圧回路300により、昇圧する電圧は昇圧制御部400から出力されるデューティ比駆動信号のデューティ比と関連する。デューティ比が大きければ実昇圧電圧Vbpigは高くなり、デューティ比が小さければ実昇圧電圧Vbpigは低くなる。

[0010]

又、本出願人は、前記ダイオードDの代わりに、ソースがコイルLに接続され、ドレインが電気負荷Fに接続したトランジスタ(MOSーFET)を備えた昇圧回路を提案している(特許文献 2)。この構成においては、両トランジスタを交互にオンオフする、同期整流方式にて制御しているが、フィードバック制御においては、図5の従来例と同様に制御するようにしている。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

【特許文献1】

特開平6-311733号公報

【特許文献2】

特開2003-89360号公報

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、従来のフィードバック制御では、電源電圧(入力電圧) $Vpigが安定していれば、なんら問題はない。しかし、電源電圧 <math>Vpigが変動した場合、フィードバックされていない変動当初は、デューティ比(オンデューティ) <math>\alpha$ が変わらないため、電源電圧 Vpigが上昇(増加) すると実昇圧電圧 <math>Vpigも上昇(減少)し、反対に電源電圧 <math>Vpigが下降すると実昇圧電圧 <math>Vpig 下降する。そして、フィードバック制御によって、目標昇圧電圧 Vpig と変動した実昇圧電圧 Vpig と変動した実昇圧電圧 Vpig と変動した実昇圧電圧 Vpig との偏差も変動し、同偏差の解消のために算出されるデューティ比(オンデューティ) α も変化することにより、目標昇圧電圧 Vpig を変かる。

[0013]

しかし、フィードバック制御では、応答性に限界があるため、電源電圧 Vpig の急峻な変動に対しては追従できず、実昇圧電圧 Vbpigが安定しない問題がある

[0014]

本発明の目的は、上記問題点を解消して、電源電圧(入力電圧)の急峻な変動に対する実昇圧電圧の変動を抑制することができる昇圧回路及び昇圧回路の制御 方法を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

上記問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、スイッチング素子がオンのときにコイルにエネルギーを蓄え、オフのときにこのエネルギーを入力電圧に重畳して出力側に設けられたコンデンサを充電する昇圧回路において、前記入力電圧と、前記コンデンサ側の実昇圧電圧を検出する検出手段と、目標昇圧電圧を設定する目標昇圧電圧設定手段と、前記目標昇圧電圧と、前記実昇圧電圧の偏差を解消するようにデューティ比を設定するデューティ比設定手段と、前記入力電圧に基づいて得られる入力電圧変動量に応じた補正量を算出し、前記デューティ比を同補正量にて補正して、新たなデューティ比に基づき、前記スイッチング素子をオンオフ作動してフィードバック制御を行う制御手段を備えたことを特徴とする昇圧回路を要旨とするものである。

[0016]

請求項2の発明は、請求項1において、前記補正量は、前記入力電圧に基づき 算出した入力電圧変動量と前記目標昇圧電圧との比であることを特徴とする。

請求項3の発明は、請求項1において、前記補正量は、前記入力電圧に基づき 算出した入力電圧変動量と前記実昇圧電圧との比であることを特徴とする。

[0017]

請求項4の発明は、スイッチング素子がオンのときにコイルにエネルギーを蓄え、オフのときにこのエネルギーを入力電圧に重畳して出力側に設けられたコンデンサを充電する昇圧回路の制御方法において、前記入力電圧と、前記コンデンサ側の実昇圧電圧を検出し、目標昇圧電圧と、前記実昇圧電圧の偏差を解消するようにデューティ比を設定し、前記入力電圧に基づいて得られる入力電圧変動量に応じた補正量を算出し、前記デューティ比を同補正量にて補正した新たなデューティ比に基づいて、前記スイッチング素子をオンオフ作動してフィードバック

制御を行うことを特徴とする昇圧回路の制御方法を要旨とするものである。

[0018]

請求項5の発明は、請求項4において、前記補正量は、前記入力電圧に基づき 算出した入力電圧変動量と前記目標昇圧電圧との比であることを特徴とする。

請求項6の発明は、請求項4において、前記補正量は、前記入力電圧に基づき 算出した入力電圧変動量と前記実昇圧電圧との比であることを特徴とする。

[0019]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を具体化した昇圧回路の実施形態を図1~図3を参照して説明する。図1は、昇圧回路100の電気回路図、図2は制御プログラムのフローチャート、図3は、デューティ比駆動信号の波形図である。

[0020]

本実施形態は、バッテリ電圧である電源電圧(入力電圧)を昇圧する昇圧回路 100である。なお、前記従来例と同一構成については、同一符号を付して、そ の詳細な説明を省略する。

[0021]

本実施形態は、前記従来例の構成中、ダイオードDの代わりに、トランジスタQ2が設けられている。トランジスタQ2は、ソースがコイルLの出力端子に接続され、ドレインが電気負荷Fに接続されている。又、トランジスタQ2のゲートは昇圧制御部200に接続されている。前記コンデンサCはトランジスタQ2の出力端子となるドレインに接続されている。なお、トランジスタQ1は、ドレインがコイルLの出力端子とトランジスタQ2の接続点に接続され、ソースが接地されている。又、トランジスタQ1のゲートは昇圧制御部200に接続されている。

[0022]

バッテリBとコイルLの接続点である電圧印加点P1の電圧検出のために、電圧印加点P1はA/D変換部(図示しない)及び昇圧制御部200のCPUの電圧入力ポート(共に図示しない)に接続され、電源電圧(入力電圧)Vpigを実測値として検出可能にされている。又、コンデンサCと電気負荷Fの接続点であ

る電圧印加点 P 2 の電圧検出のために、電圧印加点 P 2 は A / D変換部(図示しない)及び昇圧制御部 2 0 0 の C P U の電圧入力ポート(共に図示しない)に接続され、実昇圧電圧 V bp igを実測値として検出可能にされている。

[0023]

なお、前記トランジスタQ1及びトランジスタQ2はnチャンネル形のMOSFETからなる。トランジスタQ1は本発明のスイッチング素子に相当する。なお、トランジスタQ1を第2スイッチング素子としたとき、トランジスタQ2は第2スイッチング素子に相当する。

[0024]

次に、前記両トランジスタを制御する昇圧制御部200について説明する。

昇圧制御部200は、図示しないROM, RAM, CPU (中央演算処理装置)等を備えたECU (電子制御装置)から構成されている。なお、図1において、昇圧制御部200内のブロックは、前記ROM内に格納された昇圧制御プログラムにより、前記CPUが実行する機能を示す制御ブロックを示しており、図示されている各部は、独立したハードウエアを示すものではなく、前記制御プログラムで実行される機能を示す。

[0025]

昇圧制御部200は、目標昇圧電圧設定部210、フィードバック制御部220、PWM出力部230、微分器240,補正量演算部250、及び加算器260を備える。目標昇圧電圧設定部210は、前記ROMに予め格納された目標昇圧電圧Vbpig*を読み込みして、目標昇圧電圧Vbpig*をフィードバック制御部220に出力する。

[0026]

 算して、加算器260に出力する。

[0027]

一方、微分器 240 は図示しない A / D 変換部、及び電圧入力ポートを介して入力した電圧印加点 P1 の電源電圧(入力電圧) Vpigを時間微分し、入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ を算出する。補正量演算部 250 は、入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ に応じた補正量(補正値)を算出する。本実施形態では、補正量 β として入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ と目標昇圧電圧 Vpig*との比($\beta = \Delta Vpig$ /Vpig*)を演算する。なお、時間微分されて得られた入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ は、電源電圧が上昇(増加)した場合には、 $\Delta Vpig$ >0 であり、電源電圧 Vpigが下降(減少)した場合には、 $\Delta Vpig$ <0 となる。従って、補正量 β も、電源電圧 Vpigの上昇下降に応じて同様に正負の値を取る。

[0028]

加算器 260 は、デューティ比(オンデューティ) α から、入力電圧変動量 Δ Vpigと目標昇圧電圧 Vbpig*との比($\beta = \Delta$ Vpig/Vbpig*)を減算した値を新たなデューティ比 α として、PWM出力部 230 に入力する。

[0029]

PWM出力部 230では、前記新たなデューティ比(オンデューティ) α に基づいてトランジスタ Q 1 用のデューティ比駆動信号(PWM駆動信号)に変換し、該変換したデューティ比駆動信号を昇圧回路 100 のトランジスタ Q 1 に印加する。このデューティ比駆動信号により、トランジスタ Q 1 は、デューティ制御される。

[0030]

又、PWM出力部230では、前記新たなデューティ比(オンデューティ) α に基づいてトランジスタQ2用のデューティ比($1-|\alpha|$)が求められ、このデューティ比をデューティ比駆動信号(PWM駆動信号)に変換する。該変換したデューティ比駆動信号を昇圧回路100のトランジスタQ2に印加する。このデューティ比駆動信号により、トランジスタQ2は、デューティ制御される。このようにして、トランジスタQ1とトランジスタQ2に対して印加して交互にオンオフ制御する同期整流方式(図3参照)にて両トランジスタは制御される。

[0031]

図3は両トランジスタQ1, Q2に印加するパルス信号(デューティ比駆動信号)を示しており、 $T\alpha$ はオン時間、Tはパルス周期、 α はトランジスタQ1に係るデューティ比(オンデューティ)である。又、トランジスタQ2に対しては、トランジスタQ1がオンのときは、オフとし、トランジスタQ1がオフのときには、オンするパルス信号(デューティ比駆動信号)が印加される。

[0032]

このデューティ制御により、トランジスタQ1がオンとなるとコイルLに電流が流れ、トランジスタQ1がオフとなるとコイルLに流れる電流が遮断される。コイルLに流れる電流が遮断されると、この電流の遮断による磁束の変化を妨げるように、トランジスタQ1のドレイン側に高電圧が発生する。この繰り返しによって、トランジスタQ1のドレイン側に高電圧が繰り返し発生し、コンデンサーCで平滑(充電)され、昇圧された実昇圧電圧Vbpigが得られる。

[0033]

このとき、昇圧回路 1 0 0 により、昇圧する電圧は昇圧制御部 2 0 0 から出力されるデューティ比駆動信号のデューティ比と関連する。デューティ比が大きければ実昇圧電圧 V bpig は低くなる。

[0034]

そして、電源電圧Vpigに変動があった場合、入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ と目標昇圧電圧Vbpig*との比($\beta = \Delta Vpig/Vbpig$ *)にて、フィードバック制御部 220にて得られたトランジスタQ1のデューティ比 α が補正されて、新たなデューティ比 α が求められる。すなわち、フィードフォワード制御が行われる。

[0035]

例えば、電源電圧Vpigが上昇した場合、フィードバック制御部 2 2 0 にて得られたトランジスタQ 1 のデューティ比(オンデューティ) α から、補正量 β (>0) が減算され、新たなトランジスタQ 1 のデューティ比 α は、電源電圧Vpi gの上昇によるオンデューティの上昇が抑えられたものとなる。

[0036]

又、電源電圧Vpigが下降した場合、フィードバック制御部 2 2 0 にて得られたトランジスタQ 1 のデューティ比(オンデューティ) α から、補正量 β (< 0) が減算(正確には、補正量はこの場合、負となるため加算である)される。新たなトランジスタQ 1 のデューティ比 α は、電源電圧Vpigの下降によるオンデューティの下降が抑えられたものとなる。

[0037]

この結果、電源電圧(入力電圧) Vpigの変動に応じてデューティ比(オンデューティ) α がフィードフォワード制御されることにより、電源電圧(入力電圧) Vpigの変動に応じた実昇圧電圧 Vpigの変動が抑制される。特に、電源電圧(入力電圧) Vpigの急峻な変動に対して、実昇圧電圧 Vpigの変動が抑制できることになる。

[0038]

昇圧制御部200は検出手段、目標電圧設定手段、デューティ比設定手段、制御手段を構成する。

(第1実施形態の作用)

さて、図2は、昇圧制御部200のCPUが実行する昇圧制御プログラムのフローチャートであり、所定の制御周期で実行される。

[0039]

S10では、目標昇圧電圧 Vbpig*、実昇圧電圧 Vbpig、電源電圧(入力電圧) Vpig等の各種データを読込む。S20では、目標昇圧電圧 Vbpig*と、実昇圧電圧 Vbpigとの偏差を算出する。S30では、前記偏差に対して、比例(P)・積分(I)・微分(D)処理を施してトランジスタQ1の制御量を演算する。S40では、S30で演算した制御量に対応するデューティ比(オンデューティ) α を演算する。S20~S40は、フィードバック制御部220に相当する。又、S40はデューティ比設定手段に相当する。

[0040]

S50では、電源電圧(入力電圧)Vpigを時間微分し、入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ を算出する。S50は、微分器 240に相当する。S60では、入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ に応じた補正量(補正値)を算出する。すなわち、補正量 β として入

力電圧変動量 Δ Vpigと目標昇圧電圧 Vbpig*との比($\beta=\Delta$ Vpig/Vbpig*)を演算する。S 7 0 では、S 3 0 で得られたデューティ比(オンデューティ) α から、入力電圧変動量 Δ Vpigと目標昇圧電圧 Vbpig*との比($\beta=\Delta$ Vpig/Vbpig*)を減算して補正し、その値を新たなデューティ比 α とする。S 7 0 は前記加算器 2 6 0 に相当する。そして、S 8 0 では、前記新たなデューティ比(オンデューティ) α に基づいてトランジスタQ 1 用のデューティ比駆動信号(PWM駆動信号)に変換し、該変換したデューティ比駆動信号を昇圧回路 1 0 0 のトランジスタQ 1 に印加する。又、S 8 0 では、新たなデューティ比(オンデューティ) α に基づいてトランジスタQ 2 用のデューティ比(1-1 α 1)を求め、このデューティ比をデューティ比駆動信号(PWM駆動信号)に変換して、該変換したデューティ比駆動信号を昇圧回路 1 0 0 のトランジスタQ 2 に印加する。S 8 0 は前記 PWM出力部 2 3 0 に相当する。

[0041]

第1実施形態によれば、以下のような特徴がある。

$[0\ 0\ 4\ 2]$

又、第1実施形態の昇圧回路100は、電源電圧(入力電圧) Vpigと、実昇 圧電圧 Vbpigを検出する昇圧制御部200 (検出手段)を備え、同昇圧制御部2 00は、目標昇圧電圧設定手段として目標昇圧電圧 Vbpig*を設定するようにし た。そして、昇圧制御部200 (デューティ比設定手段)は、目標昇圧電圧 Vbp ig*と、実昇圧電圧 Vbpigの偏差を解消するようにデューティ比αを設定した。 そして、昇圧制御部 2 0 0 (制御手段) は、電源電圧(入力電圧) V_{pig} に基づいて得られる入力電圧変動量 Δ V_{pig} に応じた補正量 β を算出した。具体的には、昇圧制御部 2 0 0 は、補正量 β として、入力電圧変動量 Δ V_{pig} と目標昇圧電圧 V_{pig} との比(V_{pig} 2 V_{pig} 4 を演算するようした。そして、昇圧制御部 V_{pig} 4 は前記デューティ比(オンデューティ) V_{pig} 4 を同補正量 V_{pig} 5 にで補正して、補正後のデューティ比(オンデューティ) V_{pig} 6 に基づき、トランジスタ V_{pig} 7 に基づき、トランジスタ V_{pig} 8 にて補正して、一下バック制御を行うようにした。

[0043]

この結果、電源電圧(入力電圧)Vpigの変動に応じてデューティ比(オンデューティ) α がフィードフォワード制御されることにより、電源電圧Vpigの変動に応じた実昇圧電圧Vbpigの変動が抑制され、電源電圧Vpigの急峻な変動に対して、実昇圧電圧Vbpigの変動が抑制できる。この結果、電源電圧(入力電圧) 変動に対するフィードバック制御の応答性が向上できる。

[0044]

(第2実施形態)

次に、第2実施形態を図4を参照して説明する。なお、第1実施形態と同一構成については、同一符号を付し、異なるところを中心に説明する。

[0045]

第2実施形態では、補正量 β の算出の仕方が第1実施形態と異なっている。具体的には、昇圧回路100の構成では、図4において、補正量演算部250の代わりに、補正量演算部250Aが設けられており、他の構成は第1実施形態と同一である。補正量演算部250Aでは、補正量 β として、入力電圧変動量 Δ Vpigと実昇圧電圧Vbpigとの比($\beta = \Delta$ Vpig/Vbpig)を演算する。

[0046]

又、第2実施形態も、第1実施形態とほぼ同様に図2のフローチャートで示す制御プログラムを昇圧制御部200(図示しないCPU)が実行するが、S60では、補正量 β として、入力電圧変動量 Δ Vpigと実昇圧電圧Vbpigとの比(β = Δ Vpig/Vbpig)を演算するところが異なる。なお、他のステップは第1実施形態と同じである。



なお、第2実施形態においても、時間微分されて得られた入力電圧変動量 Δ V pigは、電源電圧が上昇(増加)した場合には、 Δ Vpig>0であり、電源電圧 V pigが下降(減少)した場合には、 Δ Vpig<0となる。従って、補正量 β も、電源電圧 Vpigの上昇下降に応じて同様に正負の値を取る。

[0048]

第2実施形態によれば、以下のような特徴がある。

[0049]

又、第2実施形態の昇圧回路100は、電源電圧(入力電圧)Vpigと、実昇 圧電圧Vbpigを検出する昇圧制御部200(検出手段)を備え、同昇圧制御部2 00は、目標昇圧電圧設定手段として目標昇圧電圧Vbpig*を設定するようにし た。そして、昇圧制御部200(デューティ比設定手段)は目標昇圧電圧Vbpig *と、実昇圧電圧Vbpigの偏差を解消するようにデューティ比αを設定した。

[0050]

そして、昇圧制御部 2 0 0 (制御手段) は、電源電圧(入力電圧) V_{pig} に基づいて得られる入力電圧変動量 Δ V_{pig} に応じた補正量 β を算出した。具体的には、昇圧制御部 2 0 0 は、補正量 β として、入力電圧変動量 Δ V_{pig} と実昇圧電圧 V_{pig} との比($\beta = \Delta$ V_{pig} / V_{pig})を演算するようした。そして、昇圧制御部 2 0 0 (制御手段)は前記デューティ比 α を同補正量 β にて補正して、補正後のデューティ比 α に基づき、トランジスタ Q 1 をオンオフ作動してフィードバ



ック制御を行うようにした。

[0051]

この結果、第1実施形態と同様に、電源電圧(入力電圧)変動に対するフィードバック制御の応答性が向上できる。

なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。

[0052]

(1) 前記第1実施形態では、補正量 β として、入力電圧変動量と前記目標昇圧電圧との比や、入力電圧変動量と前記実昇圧電圧との比としたが、これに限定するものではなく、補正量として入力電圧変動量 Δ Vpigに定数を乗算したものでもよい。

[0053]

(2) 前記各実施形態では、トランジスタQ2を備えた昇圧回路100に具体化したが、トランジスタQ2に代えて、従来例と同様に接続したダイオードや、ツェナーダイオードに変更した昇圧回路に具体化してもよい。

[0054]

(3) 前記各実施形態では、昇圧制御部200のブロックで示した、210~260の各部の機能を1つのCPUで行うようにしているが、各部の機能を複数のCPUで分担してもよい。

[0055]

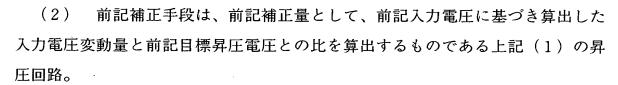
(4) 前記各実施形態では、S50, S60の処理を $S20\sim S40$ の処理 の後に行ったが、S50, S60の処理を $S20\sim S40$ の処理の前に行っても よい。

[0056]

前記各実施形態によって把握される技術的思想を以下に挙げる。

(1) 前記制御手段は、前記入力電圧に基づいて得られる入力電圧変動量に 応じた補正量を算出する補正手段を含むことを特徴とする請求項1乃至請求項3 のいずれか1項に記載の昇圧回路。前記各実施形態において、昇圧制御部200 は補正手段に相当する。

[0057]



[0058]

(3) 前記補正手段は、前記補正量として、前記入力電圧に基づき算出した 入力電圧変動量と前記実昇圧電圧との比を算出するものである上記(1)の昇圧 回路。

[0059]

【発明の効果】

以上詳述したように、請求項1乃至請求項6の発明によれば、電源電圧(入力電圧)の急峻な変動に対する実昇圧電圧の変動を抑制することができる効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1実施形態に具体化した昇圧回路の電気回路図。
- 【図2】昇圧制御プログラムのフローチャート。
- 【図3】デューティ比駆動信号の波形図。
- 【図4】第2実施形態家の昇圧回路の電気回路図。
- 【図5】従来の昇圧回路の電気回路図。
- 【図6】トランジスタのPWM駆動信号の波形図。

【符号の説明】

- 100…昇圧回路
- 200…昇圧制御部(検出手段、目標電圧設定手段、デューティ比設定手段、制御手段)

Vpig…電源電圧(入力電圧)

Δ Vpig···入力電圧変動量

Vbpig…実昇圧電圧

Vbpig*…目標昇圧電圧

α…デューティ比 (オンデューティ)

ß…補正量

B…バッテリ

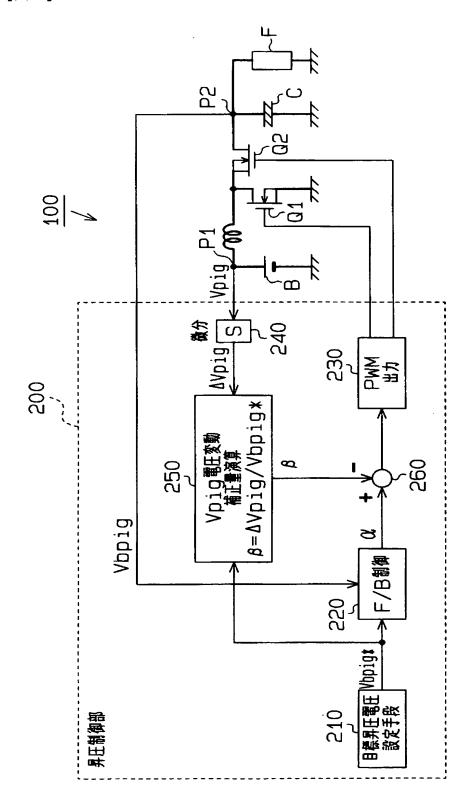
L…コイル

C…コンデンサ

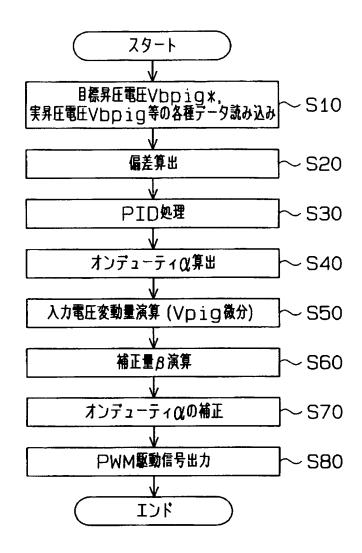
Q1…トランジスタ (スイッチング素子)

【書類名】 図面

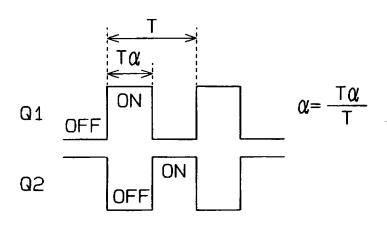
【図1】



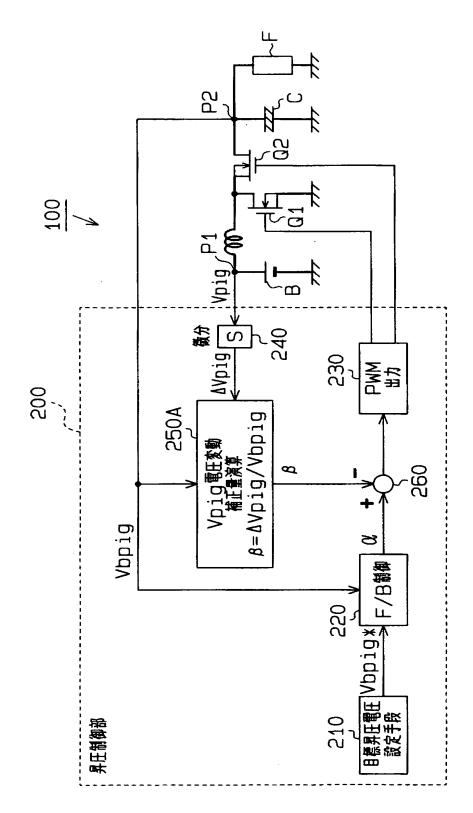
【図2】



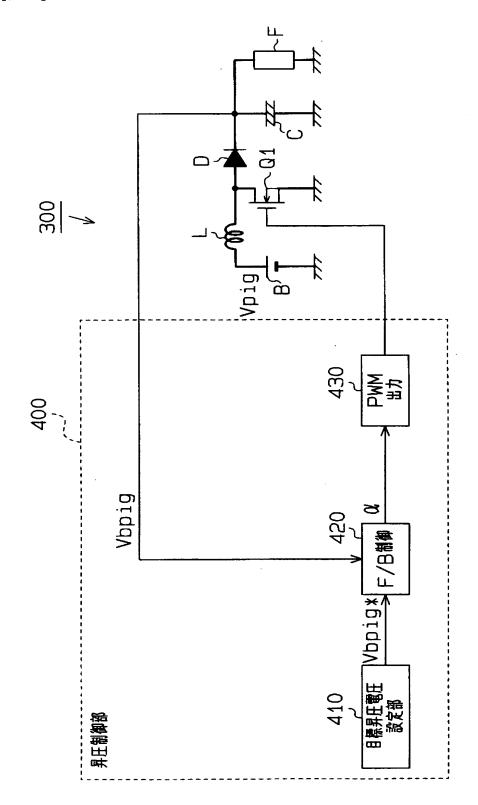
【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

Q1 OFF ON
$$\alpha = \frac{T\alpha}{T}$$



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】電源電圧(入力電圧)の変動に対する実昇圧電圧の急峻な変動を抑制することができる昇圧回路及び昇圧回路の制御方法を提供する。

【解決手段】昇圧回路 100 は電源電圧 Vpige 、実昇圧電圧 Vbpige 検出する昇圧制御部 200 を備え、同昇圧制御部 200 は、目標昇圧電圧 Vbpig* を設定する。昇圧制御部 200 は目標昇圧電圧 Vbpig* と、実昇圧電圧 Vbpigの偏差を解消するようにデューティ比を設定する。昇圧制御部 200 は電源電圧 Vpigに基づいて得られる入力電圧変動量 $\Delta Vpig$ に応じた補正量 β ($=\Delta Vpig$ /Vbpig*) を演算する。昇圧制御部 200 は前記デューティ比 α を同補正量 β にて補正して、補正後のデューティ比 α に基づき、トランジスタ Q 1 をオンオフ作動してフィードバック制御を行う。

【選択図】 図1



特願2003-112981

出願人履歴情報

識別番号

[000003470]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月24日

住所

新規登録 愛知県刈谷市朝日町1丁目1番地

氏 名

豊田工機株式会社